**文章编号:** 0258-7025(2010)04-1099-05

# 不同退火气氛下 Yb: Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>晶体的 光谱和激光性能研究

王晓丹1 马春兰1 徐晓东2 赵志伟2 梁晓燕2 徐 军3

1苏州科技学院物理科学与技术系, 江苏 苏州 215009

<sup>2</sup> 中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800

<sup>3</sup> 中国科学院上海硅酸盐研究所,上海 201800

摘要 采用提拉法生长 Yb<sup>3+</sup> 掺杂原子数分数为 10%高质量的 Yb:Lu<sub>3</sub> Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (Yb:LuAG) 晶体。对晶体在不同气 氛下退火的光谱性能进行了表征。研究发现,吸收光谱中 363 和562 nm附近的吸收带与 Yb<sup>2+</sup> 有关。晶体在空气 气氛下退火后,测得的荧光光谱强度最强,荧光寿命最长。增益截面曲线的研究表明 Yb:LuAG 晶体具有宽的发射 带。在抽运功率为9.59 W的激光二极管(LD) 抽运下, Yb:LuAG 晶体获得3.05 W的连续激光输出, 斜率效率为 41.7%, 激光抽运阈值为40 mW。

## Spectroscopic and Laser Properties of Yb:Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> Crystal under Different Annealing Atmospheres

Wang Xiaodan<sup>1</sup> Ma Chunlan<sup>1</sup> Xu Xiaodong<sup>2</sup> Zhao Zhiwei<sup>2</sup> Liang Xiaoyan<sup>2</sup> Xu Jun<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics, University of Science and Technology of Suzhou, Suzhou, Jiangsu 215009, China
 <sup>2</sup> Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China
 <sup>3</sup> Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 201800, China

**Abstract** High quality  $Yb:Lu_3Al_5O_{12}$  (Yb:LuAG) crystal doped with 10% atom fraction  $Yb^{3+}$  was grown by the Czochralski method. After annealing under different atmospheres, the spectral properties of the crystal were characterized. The experiment indicates that the absorption band in 363 nm and 562 nm are connected with  $Yb^{2+}$ . After air annealing, the intensity of fluorescence spectra is the strongest and the fluorescent lifetime is the longest. The curve of gain cross-section indicates that Yb:LuAG crystal has a wide emission band. Under laser diode (LD) pumping with 9.59 W power, the maximum output power, the slope efficiency, and the lasing threshold of Yb:LuAG crystal are 3.05 W, 41.7%, and 40 mW, respectively.

Key words materials; Yb:LuAG single crystal; absorption spectrum; fluorescence spectrum; laser activity

## 1 引 言

掺 Yb<sup>3+</sup>的石榴石晶体是发展高功率大能量固 体激光器的最具应用潜力的激光介质之一。在掺 Yb<sup>3+</sup>的石榴石晶体中,Yb:Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>(Yb:YAG)的 研究 最 为成 熟<sup>[1~3]</sup>,在不到 10 年的时间里, Yb:YAG固体激光器的平均输出功率从最初的 23 mW增加到4 kW<sup>[4]</sup>。近几年来,研究人员把研究 重点转向 Yb:Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>(Yb:LuAG)晶体,LuAG 与YAG 晶体同为石榴石系基质晶体,具有优异的物理和机械性能,易于生长出大尺寸、高质量的晶体。2007年,法国的 Boulon 小组<sup>[5]</sup>重新提出的评估Yb<sup>3+</sup>激光晶体的准三能级激光模型中新增加了LuAG 这种基质,从小信号增益和振荡器两方面来看,Yb:LuAG晶体的性能都要优于Yb:YAG 晶体。在热导率方面,Yb:LuAG晶体的热导率随Yb<sup>3+</sup>掺杂浓度的增加基本不变,而Yb:YAG 晶体的热导率

作者简介:王晓丹(1980-),女,博士,讲师,主要从事激光材料的生长及性能表征方面的研究。

收稿日期:2009-06-11; 收到修改稿日期:2009-07-09

随 Yb<sup>3+</sup> 掺杂浓度的增加迅速减小。综上所述, Yb:LuAG晶体将成为未来发展高功率、大能量固体 激光器更具潜力的激光晶体之一。

首次报道 Yb:LuAG 晶体的是在77 K的低温 下,在 Xe 灯的抽运下,实现了1029.4 nm的激光输 出,激光的阈值为1 J。随着激光二极管(LD)的发 展,研究人员在970 nm激光二极管的抽运下,研究 Yb:LuAG晶体激光效率和温度的关系<sup>[6]</sup>。此后 Yb:LuAG晶体的闪烁性能被较多地研究<sup>[7,8]</sup>。

本文研究了高质量的Yb:LuAG晶体的光谱和 激光性能。对不同气氛下退火的吸收光谱和荧光光 谱进行了详细的表征,分析退火气氛对光谱性能的 影响。采用激光二极管抽运,研究了Yb:LuAG晶体 的激光性能。

## 2 实 验

#### 2.1 晶体生长和样品准备

晶体生长所用的原料为 Lu<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (5 N), Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (5 N), Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (5 N), 整个固相反应的方程式为

 $5 \text{Al}_2 \text{O}_3 + 3(1-x) \text{Lu}_2 \text{O}_3 + 3x \text{Yb}_2 \text{O}_3 =$ 

 $2Lu_{3(1-x)}Yb_{3x}Al_5O_{12}, \quad x = 0, 1$  (1)

晶体生长采用中频感应提拉法,铱坩锅,中频感 应加热,选择<111>方向的纯 LuAG 晶体作为籽晶, 生长过程中,转速为 27.5 r/min,拉速为 1.22 mm/h,高纯氮气作为保护气体。具体生长过 程参考文献[9]。晶体的尺寸为\$26 mm×85 mm, 如图 1 所示。晶体形状完整,无宏观缺陷,晶体内部 亦无散射颗粒。生长完成的晶体毛坯为淡蓝色,高 温空气气氛退火后,晶体变为无色透明。



## 图 1 提拉法生长的原子数分数为 10%的 Yb:LuAG晶体

Fig. 1 As grown by Czochralski method Yb doped 10% atom fraction Yb:LuAG crystal

### 2.2 吸收光谱、荧光光谱和荧光寿命的测试

晶体的吸收光谱是在 V-570 型 ultraviolet/ visible/near-IR spectrophotometer 上测定的,测试 范围为 250~1100 nm,分辨率为1 nm。荧光光谱由 JOBIN-YVON 公司生产的 TRIAX 550 型光谱仪测 得,抽运波长为 940 nm,测试范围为 950 ~ 1100 nm,分辨率为1 nm,同时测试了在940 nm激发 下,由 Tektronix TDS 420 示波器记录了 Yb<sup>3+</sup>离子 的荧光寿命。光谱测试所用样品有 3 种:原始生长 未退火晶体样品,经1600 ℃(空气气氛),48 h退火 后的晶体样品,经1600 ℃(氢气气氛),48 h退火后的 晶体样品,3 种样品均双面抛光,其尺寸为10 mm× 10 mm×1 mm。所有测试均在室温下进行。

## 2.3 激光性能的测试

光

激光二极管抽运Yb:LuAG晶体的激光实验装 置如图2所示。使用的抽运源是光纤耦合二极管激 光器,抽运源的发射波长为938 nm,通过调整激光 二极管温度抽运光波长可控制到940 nm。采用1:1 耦合成像系统将抽运光耦合进晶体。采用平凹腔, 晶体尺寸为5 nm×6 nm×2 nm,晶体未镀膜,侧 面包裹铟箔固定在热沉板上,热沉板通水冷却,温度 控制在14 ℃。腔镜中 M1 镀938 nm增透和(1045± 30) nm高反膜,M2 的直径为300 nm,镀938 nm增 透和(1045±30) nm高反膜。利用输出耦合镜实现 激光输出。



图 2 激光实验装置图 Fig. 2 Schematic of diagram of the laser experimental setup

## 3 结果和讨论

## 3.1 Yb:LuAG 晶体吸收光谱分析

图3为室温下在不同气氛下退火Yb:LuAG晶体 样品的吸收光谱图,测试范围为 250~1100 nm。从 图 3(a)可以看出,在 800~1100 nm范围内,晶体的 吸收峰位于 918,939,969,1030 nm,对应于 Yb<sup>3+</sup>的  ${}^{2}F_{7/2} \rightarrow {}^{2}F_{5/2}$ 跃迁。Yb:LuAG晶体的吸收主峰位于 939 nm,不同气氛退火对这一范围内的吸收峰的峰 形和峰位基本无影响,氢气和空气气氛退火的样品 在939 nm处的吸收系数略小于未退火的样品,相差 约为1 cm<sup>-1</sup>。在 250~800 nm范围内,不同气氛退 火对晶体样品吸收峰的形状有很大影响,如图 3(b) 所示。从图中可以看出,未退火的晶体存在两个明 显的吸收带,分别位于 363 和562 nm附近。经过高 温氢气退火后,两处的吸收系数增大,并且吸收峰位 置向长波方向移动,即发生了"红移"。在 Yb<sup>2+</sup>:YAG晶体中也存在这样的两个吸收带<sup>[10]</sup>,故 认为此吸收带与 Yb<sup>2+</sup>有关。晶体在高纯氮的惰性 气氛中生长,外界缺氧,故晶体中的 O 以 O<sub>2</sub> 的形式 扩散到外界,使得金属离子过剩,形成氧空位。氧空 位带负电,这些电子不同于一般的自由电子,它们是 被束缚在空位周围的准自由电子。这种电子与附近



的 Yb<sup>3+</sup>相联系,Yb<sup>3+</sup>就变成了 Yb<sup>2+</sup>。H<sub>2</sub> 退火,外 界气氛严重缺氧,故晶体中氧离子继续扩散到外界, 使得此处的吸收系数增加。363 nm处的吸收带是 由于晶体中 Yb<sup>2+</sup>离子的 f→d 跃迁引起的,而 562 nm处的吸收带为晶体中的 Re-F 色心所致。退 火后两处的吸收峰发生了"红移",这主要是由于 Yb<sup>2+</sup>所处的晶体场环境不同所引起的。氧化气氛 退火后,吸收峰消失,分析晶体中的 Yb<sup>2+</sup> 变成了 Yb<sup>3+</sup>,故位于 363 和562 nm附近的 Yb<sup>2+</sup> 特征吸收 带消失。



图 3 不同气氛下退火的 Yb:LuAG 晶体的吸收光谱图。(a) 800~1100 nm 范围;(b) 250~800 nm 范围 Fig. 3 Absorption spectrum of Yb:LuAG single crystal with different annealing atmospheres (a) 800~1100 nm; (b) 250~800 nm

#### 3.2 Yb:LuAG 晶体的荧光光谱与荧光寿命

室温下不同气氛退火的 Yb:LuAG 晶体样品的 荧光光谱如图4所示,从图中可以看出,荧光光谱的 峰形和峰位未发生变化,荧光峰的强度发生了很大 的变化,氧化气氛退火使得晶体的发光强度显著增 加。不同气氛下退火的Yb:LuAG晶体<sup>2</sup>F<sub>5/2</sub>能级荧 光衰减曲线和荧光寿命也出现了相同的情况,如图 5 所示。从图 5(b)中可以看出,相对于原始生长和 还原气氛退火的晶体样品,氧化气氛退火的晶体样



图 4 不同气氛下退火的 Yb:LuAG 晶体的荧光光谱图 Fig. 4 Fluorescence spectrum of Yb:LuAG single crystal with different annealing atmospheres

品荧光寿命要稍有增长。氧化气氛下退火使得晶体 样品的发光峰强度增强,荧光寿命增长。出现上述 情况,分析是由于氧化气氛使得晶体中存在的Yb<sup>2+</sup> 变成了Yb<sup>3+</sup>。Yb:LuAG晶体中的Yb<sup>3+</sup>浓度增大, 所以晶体的发光峰强度增加,荧光寿命增长。氧化 气氛退火后,晶体的颜色由生长完成时的淡蓝色变 成无色透明,也充分说明了晶体中的Yb<sup>2+</sup>变成了 Yb<sup>3+</sup>。因此,将Yb:LuAG晶体应用于固体激光器 时,应先将晶体进行氧化气氛退火处理。

荧光寿命也是表征晶体激光性能的一个重要参数,荧光寿命越长,越有利于储能。测量的<sup>2</sup>F<sub>5/2</sub>能级 荧光衰减曲线,通过数据拟合得到的<sup>2</sup>F<sub>5/2</sub>能级的荧 光寿命在0.993 ms左右,比文献[11]报道的荧光寿 命0.925 ms稍长,分析是由于晶体的自吸收效应引 起的。图 6 给出了Yb:LuAG晶体中 Yb<sup>3+</sup>能级结构 图,结合 Yb<sup>3+</sup>能级结构图可以解释晶体中出现的自 吸收效应。从能级结构图可以看出,Yb:LuAG晶体 的吸收峰和发射峰在969 和1030 nm处存在着重叠, 1030 nm处吸收峰的存在,使晶体在1030 nm处的发 射有一部分被处于邻近位置的基态 Yb<sup>3+</sup> 所 吸收,从而产生了自吸收效应(荧光捕获效应)。由



图 5 Yb:LuAG 晶体<sup>2</sup>F<sub>5/2</sub>能级荧光衰减曲线(a)和荧光寿命(b)

Fig. 5 Decay curves of the  ${}^{2}F_{5/2}$  manifold of the Yb:LuAG single crystal (a) and fluorescent lifetime (b)

10893 cm<sup>-1</sup>  ${}^{2}\mathrm{F}_{5/2}$ 10650 cm<sup>-1</sup>  $10320 \text{ cm}^{-1}$ 918 nm 969 nm 1006 nm .048 nm 939 nm nn .030 nm nm 030 969 769 cm<sup>-1</sup>  $612 \text{ cm}^{-1}$  ${}^{2}\mathbf{F}_{7/2}$ 380 cm<sup>-1</sup>

图 6 Yb<sup>3+</sup>在 LuAG 基质中的能级结构图

Fig. 6 Energy level structure of Yb<sup>3+</sup> in LuAG 于荧光捕获效应的存在,导致实测的荧光寿命比单 个离子的荧光寿命要长。D. S. Sumida 等<sup>[11]</sup>采用 在Yb:LuAG晶体两边复合纯 LuAG 晶体制成"三 明治"结构来消除荧光捕获效应的影响,测量得到了 相对准确的荧光寿命。

### 3.3 Yb:LuAG 晶体的增益截面

对于准三能级系统,增益截面是与激光应用直接相关的一个重要参数,图 7 给出了室温下 Yb:LuAG晶体在不同激发态布居分数 $\beta(\beta=N_2/2)$ 



图 7 Yb: LuAG 晶体在不同 β下的增益截面σ<sub>g</sub> Fig. 7 Gain cross-section σ<sub>g</sub> of the Yb: LuAG single crystal with different β

N)下的增益截面 σ<sub>g</sub> 曲线。增益截面 σ<sub>g</sub> 表示为

 $\sigma_{g}(\lambda_{1}) = \beta \sigma_{e}(\lambda_{1}) - (1 - \beta)\sigma_{a}(\lambda_{1}), \quad (2)$ 式中 $\sigma_{g}(\lambda_{1})$ 为激光波长 $\lambda_{1}$ 处的增益截面, $\beta$ 为处于激 发态的粒子占总粒子的分数, $\sigma_{e}(\lambda_{1}),\sigma_{a}(\lambda_{1})$ 则分别 为激光波长 $\lambda_{1}$ 处的发射截面和吸收截面。

(2) 式中用到的吸收截面( $\sigma_a$ ) 由晶体的吸收光 谱结合公式  $\sigma_a = \alpha/N$  计算得到。发射截面( $\sigma_e$ ) 由倒 易法公式  $\sigma_e(\nu) = \sigma_a(\nu) \frac{Z_1}{Z_u} \exp[(E_{zl} - h\nu)/(kT)]$  计 算得到,其中配分函数为0.88,零线能级( $\lambda_{zl}$ )为 969.6 nm。吸收和发射截面分别由 $\beta = 0$ 和 $\beta = 1$ 时 得到。Yb 离子的吸收和发射截面在 939 和 1031 nm处的峰值分别为6.69×10<sup>-21</sup>和23.73× 10<sup>-21</sup> cm<sup>2</sup>。值得注意的是,Yb<sup>3+</sup>的发射谱一直延伸 到1050 nm,宽的发射带有利于发展宽调谐激光器, 同样也有利于设计和制作飞秒激光振荡器和放大 器。

### 3.4 Yb:LuAG 晶体的激光性能

对Yb:LuAG 晶体进行激光实验,实验中调节 温度至24℃,使激光二极管抽运光波长与 Yb:LuAG晶体的最大吸收峰940 nm相匹配,耦合 输出镜的透射率为3%和6%,晶体实现激光输出的 中心波长为1030 nm,表现出非常低的激光抽运阈 值。当耦合输出镜的透射率为3%时,激光抽运阈 值为34 mW。激光二极管抽运功率为9.59 W时, Yb:LuAG晶体获得2.83 W连续激光输出,在实验 过程中没有出现饱和现象,斜率效率为36.5%。当耦 合输出镜的透射率为6%时,激光抽运阈值为 40 mW,抽运功率为9.59 W时,晶体获得3.05 W连 续激光输出,斜率效率为41.7%。激光二极管抽运 下,激光输出与输入功率的关系曲线如图8 所示。 由以上激光实验数据可以看出,耦合输出镜的透射 率为6%时,激光的输出功率和斜率效率较大,因此 耦合输出镜的透射率选 6%较为合适。晶体的最大输出功率达到3.05 W,斜率效率达到41.7%,此数据也说明生长的原子数分数为 10%的Yb:LuAG晶体质量较好,适合于较高功率激光输出,因此采用更高功率的激光二极管作为抽运源,晶体的激光输出功率将会得到进一步提高。



图 8 Yb: LuAG 晶体的激光输出功率随抽运吸收功率的变化曲线



## 4 结 论

采用提拉法生长 Yb<sup>3+</sup> 掺杂原子数分数为 10% 的高质量Yb:LuAG晶体。对晶体的光谱和激光性能 进行了研究。通过对不同气氛下退火的Yb:LuAG 晶体吸收光谱的分析,得到吸收光谱中 363 和 562 nm附近的吸收带与 Yb<sup>2+</sup>有关。通过对不同气 氛下退火晶体荧光光谱和荧光寿命的研究发现,空 气气氛下退火,晶体的荧光强度最强,荧光寿命最 长。结合吸收和荧光光谱得到 Yb<sup>3+</sup>在 LuAG 晶体 中的能级结构图。对室温下Yb:LuAG晶体在不同 激发态布居分数  $\beta$ 下的增益截面  $\sigma_g$  曲线的研究表 明,Yb:LuAG晶体具有宽的发射带,有利于发展宽 调谐激光器。当激光二极管的抽运功率为9.59 W 时,晶体获得3.05 W的连续激光输出,斜率效率为 41.7%,激光抽运阈值为40 mW。这一研究对于实现Yb:LuAG晶体的高功率激光输出具有重要意义。

## 参考文献

- 1 Hong Cai, Jun Zhou, Hongming Zhao et al.. Continuous-wave and Q-switched performance of an Yb: YAG/YAG composite thin disk ceramic laser pumped with 970nm laser diode [J]. Chin. Opt. Lett., 2008, 6(11):852~854
- 2 Tian Yubing, Tan Huiming, Cao Hongzhong et al.. Low power laser diode-pumped solid-state Yb : YAG laser at room temperature[J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(5):633~636 田玉冰,檀慧明,曹洪忠等. 低功率激光二极管抽运的室温运 转 Yb:YAG 激光器[J]. 中国激光, 2007, 34(5):633~636
- 3 Wang Jingya, Wang Xiaodan, Zhao Zhiwei et al.. Making and spectra property of the composite Yb: Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>/Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> crystal [J]. Acta Optica Sinica, 2008, 28(2):316~320 王静雅,王晓丹,赵志伟等. Yb: Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>/Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>复合晶体 的制作和光谱性能[J]. 光学学报, 2008, 28(2):316~320
- 4 J. Wallace. Commercial disk laser reaches 4 kW output [J]. Laser Focus World, 2004, 40(9):19~20
- 5 Georges Boulon. Why so deep research on Yb<sup>3+</sup>-doped optical inorganic materials [J]. J. Alloys Compd., 2008, 451(1-2):1  $\sim 11$
- 6 T. Kasamatsu, H. Sekita, Y. Kuwano, Temperature dependence and optimization of 970 nm diode-pumped Yb:YAG and Yb:LuAG lasers [J]. Appl. Opt., 1999, 38(24):5149~ 5153
- 7 A. Yoshikawa, H. Ogino, J. H. Lee *et al.*. Growth and optical properties of Yb doped new scintillator crystals [J]. *Opt. Mater.*, 2003, 24(1-2):275~279
- 8 Hiraku Ogino, Akira Yoshikawa, Jong-Ho Lee et al.. Growth and characterization of Yb<sup>3+</sup>-doped garnet crystals for scintillator application [J]. Opt. Mater., 2004, 26(4):535~ 539
- 9 Wang Xiaodan, Zhao Zhiwei, Xu Xiaodong et al.. Spectroscopic properties of Yb: Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> with Yb-doping concentration 0.5at.-% [J]. Chinese J. Lasers, 2006, 33(5):692~696 王晓丹,赵志伟,徐晓东等. Yb 掺杂原子数分数为0.5%的 Yb: Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>晶体的光谱分析[J]. 中国激光, 2006, 33(5):692~ 696
- 10 M. Henke, J. Perbon, S. Kück. Preparation and spectroscopy of Yb<sup>2+</sup>-doped Y<sub>3</sub> Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, YAlO<sub>3</sub> and LiBaF<sub>3</sub>[J]. J. Lumin., 2000, 87-89:1049~1051
- D. S. Sumida, T. Y. Fan, R. Hutcheson. Spectroscopy and diode-pumped lasing of Yb<sup>3+</sup>-doped Lu<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> (Yb:LuAG)
  [C]. OSA Proceeding on Advanced Solid-State Lasers, 1995, 24:348~350